Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0203U006659

Державний реєстраційний номер: 0100U001572

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 03-06-2003

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Одержання напівпроводникових сполук для детекторів жорсткого радіаційного випромінювання

Початок етапу: 01.2000

Закінчення етапу: 12.2002

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова

Код за ЄДРПОУ: 02071091

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 23-84-17

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський Політехнічний Інститут"

Код за ЄДРПОУ: 00027677

Місцезнаходження: пр. Перемоги 37, м. Київ, Київ, 03056, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 0442048428

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Одержання напівпроводникових сполук для детекторів жорсткого радіаційного випромінювання

Назва роботи англійською:

Fabrication of semiconductors compounds for radiations sensors

Реферат українською:

Розроблено модель радіаційно-стимульованих процесів в напівпровідниках. яка пояснює механізми взаємодії випромінювань з цими структурами. з урахуванням долі іонного зв'язку. Створено методику модифікації властивостей напівпровідників

Реферат англійською:

The model radiation-stimulating of processes in semiconductors illustrating gcars of interplay with the data by frames, with allowance for lobes of an ionic bond is built.. The procedure of modification of properties of semiconductor is built

Індекс УДК: 621.315.5/.6; 621.318.1; 666.65, 621: 315.592;621.386.82;535ю535ю372

Коди тематичних рубрик: 47.09

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Мак В.Т.

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

1. Воробйова В.А., Гевелюк С.А., Дойчо И.К., Ковалеко С.П. 621: 382ак И.Т. Лищук Д.Е., Прокопович Л.П. Вплив гама-опромінювання на фотолюмінесценцію пористого кремнію. отриманого методом хімічного травлення. Фотоелектроніка. № 9 , 2000 р. С. 31-33. 2. Gevelyuk S.A... Doycho L..K.. Kovalenko N.P. Leschuk D.E.. Mak V,T,. Chystyakov V.P. Prokopovich L.P.. Influence of a y-irradition on fotolumininescence of popous gemmanium obtained by treatent in an electric spark dicharge. photoclectitronics №10, 2001.C. 91. 3. В.Т. В.И. Малиновская , В.С. Манжара ю В.И. Хиврич. С.В. Зубрицкий Влияние гамма облучения на фотолюминесцецию монокристаллов селенида цинка//УНКФП-1. Тез.докл.конф.Т. 2, Одесса. 2002.-С.67.5490

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Сминтина В.А.

Перелік осіб-виконавців

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

